PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-288561

(43) Date of publication of application: 10.10.2003

(51)Int.Cl.

G06K 19/07 G06K 17/00

(21)Application number : 2002-092902

(71)Applicant: TOPPAN PRINTING CO LTD

(22)Date of filing:

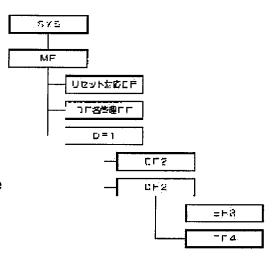
28.03.2002

(72)Inventor: NOZAKI NAOTO

(54) IC CARD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an IC card which enables initial response data to speedily be updated if the initial response data, registered in a ROM, etc., as a memory whose storage contents are unrewritable, need to be altered afterward. SOLUTION: In a nonvolatile memory, a reset response EF for writing new initial response data is provided and when a reset signal is received from outside, it is decided whether the new initial response data are written in the reset response EF; when the new initial response data are written in the reset response EF, the initial response data written in the ROM and the new initial response data in the reset response EF are read out and outputted to the outside.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.01.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-288561 (P2003-288561A)

(43)公開日 平成15年10月10日(2003, 10, 10)

(51) Int.C1.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

G 0 6 K 19/07

17/00

G06K 17/00

D 5B035

19/00

N 5B058

審査請求 未請求 請求項の数2

OL (全29頁)

(21)出願番号

特願2002-92902(P2002-92902)

(22)出願日

平成14年3月28日(2002.3.28)

(71)出願人 000003193

凸版印刷株式会社

東京都台東区台東1丁目5番1号

(72)発明者 野崎 直人

東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印

剧株式会社内

(74)代理人 100064908

弁理士 志賀 正武 (外6名)

Fターム(参考) 5B035 AA00 BA03 BB09 CA01 CA04

CA08 CA11 CA22 CA29

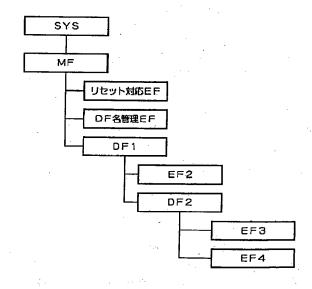
5B058 CA12 CA23 KA01 KA11

(54) 【発明の名称】 I Cカード

(57) 【要約】

【課題】 記憶内容を書き換え不可能なメモリであるR OM等に登録した初期応答データを、後に変更する必要が生じた場合には、速やかに初期応答データを更新することが可能な I C カードを提供する。

【解決手段】 不揮発性メモリ内に、新たな初期応答データを書き込むためのリセット応答EFを設け、外部からリセット信号を受信した場合に、リセット応答EF内に新たな初期応答データが書き込まれているか否かを判断し、リセット応答EF内に新たな初期応答データが書き込まれている初期応答データとリセット応答EF内の新たな初期応答データとを読み出して、外部に出力する。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 記憶内容を書き換え可能な不揮発性メモリと、該不揮発性メモリを制御する中央処理装置と、当該カード固有のプロトコルを外部に通知するための初期 応答データが予め格納されているROMとを有するICカードであって、

前記不揮発性メモリ内に、新たな初期応答データを書き込むための初期応答データ書き込み専用ファイルを具備することを特徴とするICカード。

【請求項2】 外部からリセット信号を受信した場合に、前記初期応答データ書き込み専用ファイル内に新たな初期応答データが書き込まれているか否かを判断し、前記初期応答データ書き込み専用ファイル内に新たな初期応答データが書き込まれていた場合には、前記ROM内に書き込まれている初期応答データと前記初期応答データとを読み出して、外部に出力することを特徴とする請求項1に記載のICカード。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、不揮発性メモリを 搭載したICカードに係り、特にATR (AnswerTo Res et) 情報を更新することが可能なICカードに関する。 【0002】

【従来の技術】半導体メモリ等を内蔵するICカードの登場により、従来の磁気カード等に比べて記憶容量が飛躍的に増大するとともに、マイクロコンピュータ等の半導体集積回路装置を内蔵することによってICカード自体が演算処理機能を有することで情報媒体に高いセキュリティー性を付与することができるようになった。

【0003】ICカードはISO (International Orga ni sation for Standardisation)で国際的に規格化されており、一般的にICカードはプラスチックなどを基材とするカード本体に半導体メモリ等のICが内蔵され、カード表面に外部装置との接続のために金属製の導電性端子が設けられており、そのICカードと外部装置とのデータの交信のためにICカードを外部装置のカードスロットに挿入して用いるものである。このICカードは接触型ICカードと呼ばれ、特に、大量データ交換や決済業務等交信の確実性と安全性が求められる用途、例え 40 ばクレジットや電子財布等に好適である。

【0004】一方、入退室等のゲート管理への適用に際しては、認証が主たる交信内容であって、交信データ量も少量の場合が多く、より簡略な処理が望まれる。この問題を解決するために考案された技術が非接触型ICカードである。これは、空間に高周波電磁界や超音波、光等の振動エネルギーの場を設けて、そのエネルギーを吸収、整流してカードに内蔵された電子回路を駆動する直流電力源とし、この場の交流成分の周波数をそのまま用いるか、或いは逓倍や分周して識別信号とし、この識別50

信号をコイルやコンデンサ等の複合器を介してデータを 半導体素子の情報処理回路に伝送するものである。

【0005】特に、認証や単純な計数データ処理を目的とした非接触型ICカードの多くは、電池とCPU (Central Processing Unit;中央処理装置)を搭載しないハードロジックの無線認証 (いわゆる、Radio Frequency IDentification)であり、この非接触型ICカードの出現によって、磁気カードに比較して偽造や改竄に対する安全性が高まった。また、この非接触カードによれば、無線によって外部装置と通信を行うことができるため、例えば、駅の改札等に代表されるようなゲートを通過する場合には、カード携帯者は、携帯するICカードをゲートに設けられているICカードリードライタ (以下、カードR/Wと記載する)に接近させるだけで良く、従来のゲート通過に伴う煩わしい作業をすることなく、簡単にゲートを通過することができる。

【0006】また、近年になって、多目的な用途に1枚のカードで対応することを目的として前者の外部端子を持つ接触型の機能と後者の無線通信によってデータ交信する非接触型の機能を有する複合型のICカードが考案されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】上述したようなICカードは、通常、外部装置であるカードR/Wとの間でデータの送受を行う場合、カードR/Wからのリセット信号により制御プログラムが起動され、その後、カードR/Wからのコマンドを受け取って解読し、これに対応する処理を実行した後、その処理結果を応答データとしてカードR/Wに出力し、その後待機状態となる。ところで、一般に、ICカードは機種によりその伝送プロトコルが異なる。このため、ICカードは伝送プロトコル等をカードR/Wへ通知するため、リセット信号によるリセット解除を認識後、ATR (Answer To Reset) 情報と称する初期応答データをカードR/Wに出力する。

【0008】上記ATR情報は、当該ICカードの伝送プロトコル仕様情報とICカード固有の情報とから構成されており、通常、ICカードに搭載されるICチップの製造工程で、ICチップ内のマスクROM内に書き込まれる。ここで、上記マスクROMは、書き換え不可能なメモリであるため、マスクROMに書き込んだATR情報を後に書き換えることは不可能である。

【0009】しかしながら、ICカード発行後において、ICカードのソフトウェアをバージョンアップしたい場合や、ICカードに新たなソフトウェアを追加した場合等には、ROM内に登録されている上記ATR情報を更新する必要が生じる。このようなATR情報の変更が必要となる場面は、現在多く見受けられるが、従来のICカードにおいては、ROM内に書き込まれているATR情報を書き換える又は追加することができなかったため、ICカード製造後に生じるデータ更新等に対応す

ることができなかった。

【0010】本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、記憶内容を書き換え不可能なメモリであるRO M等に登録した初期応答データを、後に変更する必要が生じた場合には、速やかに初期応答データを更新することが可能なICカードを提供することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明は、記憶内容を書き換え可能な不揮発性メモリと、該不揮発性メモリを制御する中央処理装置と、当 10 該カード固有のプロトコルを外部に通知するための初期 応答データが予め格納されているROMとを有するIC カードであって、前記不揮発性メモリ内に、新たな初期 応答データを書き込むための初期応答データ書き込み専用ファイルを具備することを特徴とするICカードを提供する。

【0012】また、請求項2に記載の発明は、請求項1に記載のICカードにおいて、外部からリセット信号を受信した場合に、前記初期応答データ書き込み専用ファイル内に新たな初期応答データが書き込まれているか否 20かを判断し、前記初期応答データきき込み専用ファイル内に新たな初期応答データが書き込まれていた場合には、前記ROM内に書き込まれている初期応答データと前記初期応答データ書き込み専用ファイル内の新たな初期応答データとを読み出して、外部に出力することを特徴とする。

【0013】なお、本発明の I Cカードの用途の代表的 なものとしては、例えば、金融関係におけるキャッシュ カード、クレジットカード、通帳、行政関係における印 鑑証明カード、住民基本台帳カード、年金手帳、運転免 30 許証、パスポート、資格保有の証明書が例として挙げら れる。また、有価証券関係における商品券、プリペイド カード、株券として、運輸関係における定期乗車券、回 数券、ETCカード、運賃精算券、有料道路通行券等が 例として挙げられる。また、医療関係においては、健康 保険証、診察券、母子手帳、カルテ、診療履歴証、医療 個人証(血液型、投与禁止薬情報等を入力)、献血手帳 等が、また、ID関係、その他の分野においては、社員 証、会員証、保険証券、ポイントカード、身分証明書、 学生証、成績表、給与明細表、出退勤管理カード、電子 40 鍵、入退室管理カード、図書館利用証、機器利用証、施 設利用証、食堂利用証、各種決済カード、電話帳、警察 手帳等が例として挙げられる。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照し、本発明の一 実施形態について説明する。まず、接触型、非接触型、 複合型等の各種ICカードについて、それぞれ基本構 造、基本動作等について概要を説明する。

【0015】 (1-1)接触型ICカードの概要 代表的な接触型ICカードの概観図を図20に、接触型 50

ICカードの電気回路構成図を図21に示す。図20に 示すように、接触型ICカード100は、プラスチック カード本体の表面の一部に外部装置とのインターフェー スとなる端子電極101が取り付けられ、その端子電極 101の下面にICチップ102が取り付けられてい る。また、カード本体の表面には、印刷文字、エンボス 文字103の形成が可能である。また、既存の磁気カー ドシステムにも対応可能とするため、磁気ストライプ1 04が設けられている場合もある。上記 I Cチップ10 2の電気回路構成は、図21に示すように、CPU (中 央処理装置)105とメモリとを備えている。メモリ は、ROM (Read Only Memory) 106、RAM (Rand om Access Memory、揮発性メモリ)107、記憶内容を 書き換え可能な不揮発性メモリとしてのEEPROM(E lectrically ErasableProgramable ROM) 108等から なる。上記ROM106にはCPU105が実行するI Cカード動作用プログラムを格納されている。また、R AM107は、コマンド(命令)等のデータの一時格納 領域やCPU105の作業領域等として使用される。E EPROM 108には、メモリデータや各種設定等が格 納される。CPUは、これらのメモリからデータを読み 出すため、また、書き込みを行うために所定幅のバスを 介して接続されている。

【0016】また、外部装置とのインターフェースである端子電極101には、外部より電源を供給するための電源端子Vcc及びグラウンド端子GNDと、外部よりリセット信号を受信するためのリセット信号端子RSTと、外部との間でデータの送受信をするためのI/O端子と、外部よりシステムクロック信号を受信するためのクロック端子CLKとを備えている。

【0017】また、CPU105は、外部装置から供給されるVcc(電源電圧)、RST信号(リセット信号)、CLK信号(クロック信号)に基づいて、ROM106に格納されたプログラムを読み出して実行し、RAM107およびEEPROM108に対してデータの書き込み及び読み出しを行うとともに、I/O端子を介して、外部機器からのコマンド・書き込みデータ等を受信し、また、ICカードからのレスポンスとしての処理結果・読み出しデータ等を送信する。接触型ICカード100は、記憶容量が大きいため、ソフトウェアも搭載可能であり、このため多機能を1枚のICカードで実現することが可能である。また、セキュリティ性に優れ、偽造、不正使用等が行われにくいという特徴を有している

【0018】(1-2) 非接触型ICカードの概要以下に、非接触型ICカードの基本的構成と基本原理について図面を用いて説明する。図22に示すように、非接触型ICカード109は、図中点線で示すようにカード本体内部にICチップ110、コイル117等を実装し、無線により外部装置とデータの送受を行う。このた

(4)

め、 I Cカード表面には、上述した接触型 I Cカード1 00のように端子電極101を要しない。次に、図23 に非接触型 I Cカード109の電気回路構成を示す。同 図に示すように、非接触型 I Cカード109は、ICチ ップ110と、共振回路部116とを備える。上記IC チップ110には、CPU (中央処理装置) 111とR OM112、RAM113、EEPROM114及びR F回路115が実装されている。なお、ICチップ11 0の電源安定のため、バイパスコンデンサ(図示略)が 設けられる場合もある。

【0019】上記共振回路部116は、コイル117と コンデンサ118とによって構成され、その共振周波数 が外部装置120の放射する高周波電磁界の周波数と等 しくなるように設定されている。これにより、外部装置 120の送受信アンテナと直接電磁的に結合され電力の 受信や情報の送受を可能とする。尚、ICチップは各社 が開発・設計しており、ICチップの製品設計によって は、非接触型ICカードに実装する際に、必ずしも上述 したような共振周波数を調整する工程を必要としない例 もあり、もちろんその場合には、このように共振周波数 20 を調整するための電気部品を設けるなどの工程は必要な

【0020】ここで、外部装置120から非接触型IC カード109に電力および情報を伝達する場合におけ る、コイル117の動作を以下に説明する。外部装置1 20の送受信回路で発生された図示しない高周波信号に より、外部装置120内部の送受信コイルに高周波電磁 界が誘起され、この高周波信号が、電磁エネルギーとし て空間に放射される。このとき、非接触型 I Cカード1 09がこの高周波電磁界中に位置すると、外部装置12 30 0の送受信コイルにより発生された髙周波電磁界によ り、電磁誘導によって、非接触型ICカード内の共振回 路部116に高周波電流が流れる。これにより、非接触 型 I Cカード109は起電力を得る。ここで、コイル1 17とコンデンサ118による共振回路部116の共振 周波数は、外部装置120が放射する高周波電磁界の周 波数に鋭く共振するように設定されている。これによ り、外部装置120から最大の電磁エネルギーを受ける ことができる。また、共振回路部116は、閉ループを 形成しているため受信したエネルギーを蓄積エネルギー 40 として保有することができる。

【0021】なお、コイル117の形成方法として、銅 箔やアルミ箔のエッチングにより形成したり、銀ペース トを印刷したり、電線を巻いたりする方法が知られてお り、また、コンデンサ118の形成方法として、アンテ ナをフレキシブル基板としてその基板の両面に電極をつ けてコンデンサを形成する方法や、フィルムコンデンサ やセラミックコンデンサを実装する方法が知られてい る。なお、コイル117及びコンデンサ118は、図2 3に示したようにICチップ110の外部に形成される 50 れることもある。これに対し、統合タイプは、接触型の

場合の他、ICチップ110内に形成される技術もあ る。なお上述した技術は、後述の複合型ICカードに応 用することも可能である。

【0022】また、非接触型ICカード109の製造方 法としては、一般的にラミネート技術によるものが知ら れている。このラミネート技術では、プレスの2枚の板 の間に複数の熱可塑性シートを積み重ねて配置し、非接 触型のICチップ110をその中間に配置する。このI Cチップ110は、予めこのICチップ110を取り囲 むコイル116等と電気的に接続されている。その配置 後、熱と圧力を加えて複数の熱可塑性シートを溶着さ せ、ICチップ110と熱可塑性シートを一体化させ、 非接触型 I Cカード109を製造する。また、上記ラミ ネート技術によるものの他、例えば、熱可塑性シートの 間にカードのサイズに合った矩形のフレームを設置し、 このフレームと中間のシートによって形成された空洞内 に、予めコイル117に接続されている I Cチップ11 0を設置し、上記空洞に熱硬化樹脂を注入し、その後、 この空洞を上記熱可塑性シートで被覆するという製造方 法もある。なお、アンテナ(一般的にコイル状のものが 多い)とICチップとの配置は、上述した例に限らず、 適宜設計しても良い。また、アンテナとICチップとの 間は、必ずしも導体で接続される必要はなく、例えば、 トランス結合などの電気工学技術を利用して、アンテナ とICチップとの間のデータ送受信などを行うようにし てもよい。

【0023】上述した非接触型ICカード109は、汚 れ、埃、始動等の外界からの影響を受けにくく、また、 操作性、端末のメンテナンスに優れる等の特徴を有す る。また、外部装置120と接触させなくても情報の授 受が可能であることから、利便性、保守性に優れ、例え ば、鉄道等の乗車券として有効に活用することが可能で ある。

【0024】 (1-3) 複合型 [Cカードの概要・ 複合型ICカードは、上述した接触型、非接触型を一体 化したものである。複合型ICカードと称する他、ハイ ブリッド型ICカード、コンビ型ICカード、コンビカ ード、というように呼ばれることもある。また、複合型 ICカードは、インターフェースのタイプ等によって、 デュアルインターフェースタイプと統合タイプとに分か れる。

【0025】デュアルインターフェースタイプは、接触 型、非接触型のインターフェースを有するが、CPU、 メモリ (ROM, RAM, EEPROM等) を共用する タイプである。例えば、1つの I C チップに接触型、非 接型の2種類のインターフェース機能とOS (オペレー ティングシステム)を備え、一つのCPUでメモリを共 用する。なお、デュアルインターフェースICカード、 デュアル I Cカード、デュアルカードというように呼ば

ICチップ、非接触型のICチップの、二つのICチッ プを有し、CPU、メモリを共用しないタイプである。 【0026】複合型ICカードは、上述した接触型と非 接触型との2つの機能を有するため、用途に応じて広く 使い分けることが可能である。即ち、接触型 I Cカード が好ましいとされるクレジットカード、キャッシュカー ド、物販、認証利用等の高額決済、認証サービス、端末 アクセス管理、ポイントサービスや、非接触型ICカー ドが好ましいとされる物販飲食利用の少額決済、入退室 管理、ゲート利用、出欠席管理、出退勤管理用、ポイン 10 トサービスカード、定期券、乗車券等に有効に活用する ことができる。

【0027】続いて、代表的なデュアルインターフェー スタイプの複合型 I Cカード220 (以下、単に複合型 ICカードと記載する)の電気回路構成を図24に示 す。同図に示すように、複合型 I Cカード2 20は、 I Cカード全体の制御を行うCPU121と、ブートプロ グラム等の固定データが予め記録されたROM122 と、電気的にデータの書き込み、消去が可能な不揮発性 メモリであるEEPROM123と、各種データを一時 20 的に記憶するRAM124と、外部装置の端子電極と接 触することにより、電力、データの送受を行う接触型イ ンターフェース(I/F)としての端子電極125と、 非接触型インターフェース(I/F)としての共振回路 部126と、共振回路部126とCPU121との間に 介在するRF回路127とを備えている。

【0028】接触型インターフェースとして機能する上 記端子電極125は、外部より電源を供給するための電 源端子Vcc及びグラウンド端子GNDと、外部よりリ セット信号を受信するためのリセット信号端子RST と、外部との間でデータの送受信をするためのI/O端 子と、外部よりシステムクロック信号を受信するための クロック端子CLKとを備えている。上述した金属製の 各端子は、ICカードの表面に配置されており、これら の端子を外部装置である接触型カードR/Wに電気的に 接触されることにより、電力の供給やデータの送受を行

【0029】一方、非接触型インターフェースとして機 能する共振回路部126は、図23に示した上述の非接 触型ICカードと同様に、ICカード内部に形成された 40 コイル状のアンテナ及びコンデンサとから構成され、外 部装置である非接触型カードR/Wと電波により電力の 供給やデータの送受を可能とする。共振回路部126に よれば、ICカード本体がカードR/Wに接触しないた め、摩耗部分が少なく、カードR/W及びICカードの 双方の寿命が長くなる他、アンテナがICカードの内部 に設置されているため、カードの表面と裏面とを全て印 刷に使用できる、複数枚のICカードに対してほぼ同時 に読み書きができる等の利点がある。

ターフェースに対応するオペレーティングシステムと、 非接触型インターフェースに対応するオペレーションシ ステムとがそれぞれ記憶されている。また、EEPRO M123には、接触型オペレーションシステム又は非接 触型オペレーションシステム上で動作するアプリケーシ ョン、認証キー情報、データ等が格納されている。

【0031】次に、図25に上記複合型ICカード22 0の構造を示す。図25 (a)は、全体構造を示してお り、図25 (b)は、複合型ICモジュール実装部を横 切る横断面図を示したものである。同図において、共振 回路部126を構成するコイル128は、シート状の樹 脂の表面にプリントパターンで形成されており、上記コ ンデンサ129は、シート状樹脂の誘電体を介して表面 ・裏面それぞれ対向した平行平板からなる。

【0032】複合型ICモジュール130は、複合型I Cチップ131と、モジュール基板132と、端子電極 125とからなる。上記複合型ICチップ131は、図 24に示したCPU121、ROM122、EEPRO M123、RAM124、及びRF回路127が内蔵さ れた I Cチップである。複合型 I Cチップ 131と端子 電極125とは、モジュール基板132の相異なる面に 実装され、スルーホールで互いに回路接続された後に、 複合型 I C チップ131は樹脂封止される。これによ り、複合型ICモジュール130が完成する。

【0033】続いて、樹脂基板に、プリントパターンに よってコイル128と表裏面対向した平行平板のパター ンによるコンデンサ129からなる共振回路部126を 形成し、コイルとして機能するフレキシブルなアンテナ 基板134が準備される。ここでは、コイル128はプ リントパターンによる形成としたが絶縁被覆した導線を 巻いて形成する方法でもよい。また、アンテナ基板13 4の樹脂としては塩化ビニルの他、ポリイミド、ポリカ ーボネート、PET等が適用でき、材料は一種に固定さ れるものではない。

【0034】続いて、射出成形によりアンテナ基板13 4を封入してカード基板135を作製する。成形の際、 アンテナ基板134は共振回路部126と複合型ICモ ジュール130の実装位置とが、所定の位置となるよう に配置される。また、射出成形によるカード基板135 の製作と同時に、表面となるカード基板135には、複 合型ICモジュール130の嵌合穴136を形成する。 最後に、カード基板135の複合型ICモジュールの嵌 合穴136に複合型ICモジュール130を導電ペース ト等で接着することにより、複合型 I Cカード220が 完成する。なお、カード基材としては塩化ビニルの他、 ポリカーボネートなど十分な強度とエンボス性などカー ドの特性が得られるもので有ればすべて本発明に適用で

【0035】なお、図25 (a)では、カード基板13 【0030】また、上記ROM122には、接触型イン 50 5は、表面と裏面に分離して描いてあるが、本来、一体

のものであり、ここでは、カード基板135に封入され るアンテナ基板134における共振回路部126と、複 合型 I Cモジュール130が取り付けられる嵌合穴13 6との関係を明確に説明するために修飾したものであ る。また、カードの製作は、上述した射出成形の他、エ ンボス特性を維持する方法であればいずれも適用可能で あり、例えば、ラミネート方式、接着剤充填方式等が用 いられる。また、複合型 I C モジュール130の嵌合穴 136を、カード成形後にくりぬき加工することもあり 得る。

【0036】続いて、エンボスに対応した複合型ICカ ード220の平面図を図26に示す。この例では、コイ ル128を外部端子領域137に実装される複合型IC モジュール130に近接させ、更に外部端子領域137 (複合型ICモジュール130)が該コイル128のル ープの外側に位置するように配置して、エンボス領域1 38・外部端子領域137を干渉しないように配置した 場合を示している。これはコイル仕様が所定のインダク タンスを得るために、コイル128がスパイラル形状で あり、そのコイル128の幅がエンボス領域138と外 20 部端子領域137との間隙よりも広くなった場合に非常 に有効である。

【0037】次に、図27 (a)、(b) にエンボス領 域138に対応した複合型ICカード若しくはエンボス 領域138無しの場合の複合型ICカードにおけるコイ ル128の複合型ICカード220内部に於ける実装位 置を示す。コイル128はカードのほぼ周囲全体に配置 されている。このときのコイル仕様は、カードのほぼ全 周に沿って配置されるため、所定のインダクタンスを得 るのに図26における場合と比較して少ない巻数で実現 30 できる。また、コイル128の外部端子領域137に近 接する長さは任意であり、図27(b)に示すように、 外部端子領域137のほぼ3/4周を取り囲むように配 置することも可能である。この場合におけるアンテナ基 板134はエンボス領域138に対応する部分の樹脂シ ートを切り抜いてある。これは、エンボス特性に影響を 与えないことを目的としている。

【0038】また、図26及び図27では、コイル12 8の巻き方 (ループ状態) が比較的均等に揃っていた が、図28に示すように、コイル128の巻き数を非常 40 に多くし、外周径と内周径の差を大きくするようにして もよい。図28では、例えば、外部装置が放射する高周。 波電磁界の周波数が、図26及び図27の場合に比べて 1桁乃至2桁低い場合に適したコイルの巻き方である。 高周波電磁界の周波数が低くなると、当然のことながら 共振回路部126でのコイル128のインダクタンス値 およびコンデンサ129の容量値が増加する。コイル1 28のインダクタンス増加は巻数の増大につながり、プ リントパターンによるスパイラルコイル形状では外周径 と内周径の差が大きくなり図28に示す形態となる。 50 を参照して順に説明する。まず、ICカードの製造過程

【0039】(2) ICカードシステムの概要 次に、上述したようなICカードと通信を行うシステム 側(外部装置側)の構成について図42を参照して説明 する。

(2-1) ICカードシステムの構成

図29に示すように、ICカードシステムは、一般にホ ストコンピュータ140、端末装置141、及びカード R/W142から構成される。ホストコンピュータ14 0は、ICカードシステム全体を集中的に制御するもの である。端末装置141は、ホストコンピュータ140 に通信回線などで接続されており、各地に分散して多数 配置してある。カードR/W142は、例えば各店舗に 設置され、ICカードとホストコンピュータ140側と のインターフェースとして機能する。なお、ホストコン ピュータ1 40には、カード発行装置143が接続され ることもある。また、上記端末装置141としては、専 用に作られた専用端末の他に、パソコン、キャッシュデ ィスペンサー端末、ATM端末、自動販売機、入退場ゲ ート、POS (Point Of Sales) 端末、携帯電話が例と して挙げられる。

【0040】図29に示したICカードシステムにおい て、接触型のカードR/W(ICカードとしては接触 型、複合型)が使用される場合は、図30に示すよう に、カードR/W142にICカード144が挿入され ることにより、カードR/W142の端子電極と145 と、ICカード144の端子電極146とが接触し、こ の端子電極を介して信号の送受信がなされる。具体的に はカードR/W142からICカード144へ制御信号 が送信され、これに対する応答信号がICカード144 からカードR/W142へ送信される。また、ICカー ドに情報を書き込む場合には、カードR/W142とI Cカードとの間でネゴシエーションを行い、カードR/ W142が書き込みの許可を得た場合に、書き込むデー タをICカード144へ送信することで、該データの書 き込みを行うことができる。

【0041】一方、ICカード144から情報を読み出 す場合には、カードR/W142は、ICカード144 に対して読み出し要求と読み出しを所望するファイルの 情報等を送信することにより、所望の情報をICカード 144から読み出すことが可能となる。

【0042】また、図29に示した【Cカードシステム において、非接触型のカードR/W(ICカードとして は非接触型、複合型)が使用される場合は、図31に示 すように、ICカード148をカードR/W147に接 近させることにより、電磁誘導によりカードR/W14 7から起電力を得、カードR/W147との間で無線に より上述したような通信を行うことができる。

【0043】(3) ICカードの製造から発行まで 続いて、ICカードの製造から発行までの過程を図32

10

(図32のステップSP41)では、ICカード用IC チップのOS、アプリケーションソフトの開発、ICチップの設計工程、ICチップの製造工程、ICチップを プラスチック等のカードに実装する工程、ICカードに 文字や模様等の印刷を行なう工程を経る。そして、この ようにして製造されたICカードは、発行者に渡され、 発行処理が行なわれる(ステップSP42)。

【0044】発行処理では、カードのフォーマット(EEPROMの初期化処理)、CDF(Common Data File)を生成する処理が行われる。また、CDFには、カードの属性情報、カードの発行者、カードの所有者を特定する情報、アプリケーションソフトへのアクセス権限の情報、PIN(Personal Identification Number)情報(個人識別情報)等が記憶される。また、ADF(Application Data File)を生成する。ADFには、アプリケーション内のファイルへのアクセス権限の情報、アプリケーション内で用いられるPIN情報等が格納される。

【0045】そして、上述したような発行処理された I Cカードは、使用者に渡され、サービス提供者が提供す 20 るサービスを、使用者が I Cカードを使って受けることができる (ステップSP43)。なお、初回使用時に、使用者が端末を用いて暗証番号等を設定する場合もある

【0046】(4) I Cカードのメモリ管理方法 次に、I Cカードのメモリ管理方法の一実施形態について図1~図15を参照して説明する。なお、ここでのメモリ管理方法は、上述した接触型、非接触型、複合型のI Cカードにそれぞれ適用可能であるが、簡単のため、図20~図21において説明した接触型I Cカード10300に本発明のメモリ管理方法を適用する場合について説明する。

【0047】まず、図33に、原国際規格ISO/IE C7816シリーズにより規定されている基本的なファ イル階層構造を示す。このファイル構造において、MF (Master File) は最上位に位置するファイルであり、 `ファイル構成の根幹となる唯一の必須専用ファイルであ る。そして、上記MFの配下に、DF (Dedicated Fil e) 、及びEF (Elementary File) が構成される。DF は、ファイル制御情報及び任意選択の割付可能メモリを 40 含むファイルであり、EF、及び又は専用ファイルの親 ファイルとなることができる。EFは、同一のファイル 識別子を有しているデータ単位又はレコードの集合であ り、アプリケーションプログラム、データ等を格納する WEF (Working EF) と、認証鍵及び暗号を格納する IEF (Internal EF) 等がある。そして、上述した ような階層構造を持つファイルが上述した各種ICカー ドに使用される不揮発性メモリとしてのEE PROMに 格納されている。

【0048】 (4-1) 本実施形態に係るファイル階層 50

構造

続いて、本実施形態における具体的なファイル階層構造を図1に示す。なお、本実施形態では、図20に示した接触型ICカード100のEEPROM108に図1に示したファイルが格納される。

【0049】このファイル階層構造は、図33に示した原国際規格ISO/IEC7816シリーズに準拠したものであり、その構造は、ファイルの最上位に配置されたMFの配下に、リセット応答EF、DF名管理EF、DF1が連なり、更に、DF1の配下に、EF2及びDF2が連なり、DF2の配下にEF3及びEF4が連なる階層構造となっている。なお、上記MFの上位には、当該MF並びにMF配下に存在するファイルを格納するEEPROMのメモリマップの状態を管理するシステムディレクトリsysが生成される。

【0050】 (4-2) 本実施形態に係るディレクトリ 及びファイルのレイアウト

そして、各ファイルは、ディレクトリによって管理される。ディレクトリは、図2に示すようなレイアウトを有し、当該ディレクトリが生成されているものであるか又は削除されたものであるかを示すディレクトリ生成・削除フラグFLG、ファイルID(ファイル番号)FID、配下に存在するファイルの先頭セクタ(区画)番号(先頭論理アドレス)TOP、配下に存在するファイルの最終セクタ(区画)番号(最終論理アドレス)BTM、ファイルサイズ(全セクタ数)VLMをそれぞれ登録するメモリ領域を有する。また、上述したDFには、ファイル名を付与することができ、ファイル名を書き込むメモリ領域のレイアウトは、図3に示すように、ディレクトリ生成・削除フラグFLG、DFディレクトリの先頭論理アドレスTOP D、及びファイルのID名(DF名)を格納するメモリ領域とを有する。

【0051】なお、本実施形態において、ファイルの生成、削除は、32バイトからなる1セクタ(1区画)を最小単位として取り扱う。また、上記ディレクトリは原則として1セクタを要する。

【0052】 (4-3) ファイルの生成

以下、図4に示したファイル階層構造と、図5〜図15に示したEEPROMのメモリマップの遷移図とを参照し、ファイル生成の処理について説明する。なお、図4は、図1に示したファイル構造において、ディレクトリを構造内に表したものである。

【0053】まず、EEPROM (不揮発性メモリ)の 初期状態におけるメモリマップを図5に示す。図5に示すように、EEPROMのメモリ領域は、ファイル領域 と、FAT (file Allocation Table) 領域 (ファイル管理領域) とに分割されている。本実施形態では、物理アドレス「h'000000」~「h'049990」をファイル領域に、「h'050000」以降の物理アドレスをFAT領域に割り当てている。

【0054】上記ファイル領域においては、32バイト からなる1セクタ毎に論理アドレスが割り当てられてい る。なお、図中「h'」で始まるアドレスは物理アドレス を示しており、「#」で始まるアドレスは、論理アドレ スを示している。ここで、論理アドレスとは、EEPR OM上に実際に割り当てられたアドレスではなく、ファ イルを管理するためにプログラム上で使用される仮想 (論理上)のアドレスであり、16進で表記されてい る。これに対し、物理アドレスとは、1バイト毎に割り 当てられている番地であり、16進で表記されている。 なお、ハードウェアでは、物理アドレスを使用している ため、ソフトウェア上において、物理アドレスと論理ア ドレスとの変換処理が必要となる。

【0055】一方、FAT領域には、セクタ(区画)Y の各々に対応する管理セクタFを設け、管理セクタFの 各々には、対応する区画の使用状態等を登録する。互い に対応するセクタYと管理セクタFとは、同一の論理ア ドレスで識別され、図中網掛けで示されている番号は、 FAT領域において各管理セクタFに割り当てられた論 理アドレスである。

【0056】なお、FAT領域における論理アドレス (FAT領域における網掛け部分) は、実際には、メモ リマップ上には存在しない。また、FAT領域における 管理セクタFは2バイトで構成されているため、2バイ ト毎に論理アドレスが割り当てられていることとなる。 なお、FAT領域においては、1行16バイトで表示し ているため、2行で1セクタYに相当する32バイトを 示している。

【0057】また、図5においては、全てのメモリエリ アに初期値「FFF」が記憶されている。この状態は、E 30 EPROMの全てのメモリ領域にデータが何も入ってい ない状態を表しており、フォーマット前、即ち、製造し た直後のEEPROMの状態に相当する。なお、「FFF F」に代わって「0000」が記憶されている場合もある。

【0058】続いて、接触型ICカード100が外部装 置(例えば、図43におけるカードR/W142)に挿 入されることにより、I/O端子を介してフォーマット 実行のコマンドと、確保するセクタ数とを受信すると、 ICカード内のCPU105は、図5に示した初期状態 のEEPROM108に対し、フォーマット処理を実行 40 する。

【0059】このフォーマット実行処理では、まず、命 令を受けた数の空きセクタをファイル領域に確保し、そ の確保した空きセクタに対応する管理セクタFをFAT 領域に生成する。その後、システムディレクトリ(SY S) とMFディレクトリ (MF) とを確保した空きセクタ に生成する。以下、確保する空きセクタ数として256 セクタが指示された場合について説明する。

【0060】〈管理セクタのリンク付け〉まず、ファイ

256セクタ分の空きセクタを確保すべく、確保する空 きセクタに各々対応する管理セクタをFAT領域に生成 する。具体的には、FAT領域において「#0000」の管 理セクタに、次の論理アドレスへのリンク情報として 「*0001」を登録し、続く「#0001」には次の論理アドレ スのリンク情報として「*0002」を登録する。同様にし て、各管理セクタに次の論理アドレスへのリンク情報を 登録し、最終セクタに対応する論理アドレス「#OFF」 の管理セクタには、最終コードを示す「FFFF」を登録す る。このようにして、各管理セクタに次の論理アドレス へのリンク情報を登録することにより、論理アドレス 「#0000」~「#00FF」の連続する256セクタを空きセ クタとして確保する。

【0061】 (システムディレクトリ (SYS) の生成) 続いて、CPU105は、図4に示したファイル構造に おいて最上位に位置するシステムディレクトリ(SYS) の生成処理を実行する(図4のSP1)。まず、ファイ ル領域の先頭物理アドレス「h' 000000」~「h' 00001F」 からなる1 セクタ目に、システムディレク トリを生成す る。これは、1セクタ目のディレクトリ生成・削除フラ グ格納エリア(以下、単にFLGと記載する)に、ディレ クトリを作成したことを示すための「01」を書き込み、 続いて、先頭セクタ番号 (先頭論理アドレス) 格納エリ アTOP (以下、単にTOPと記載する) に、現在の空きセク タの先頭論理アドレスである「#0000」を書き込み、最 終セクタ番号格納エリアBTM(以下、単にBTMと記載す る)に空きセクタの最終論理アドレスである「#OFF」 を書き込み、ファイルサイズ格納エリアVLM(以下、単 にVLMと記載する) に現在の空きセクタ数である「010 0」を書き込む。なお、このセクタ数も16進表記であ る。これにより、図6に示すように、システムディレク トリが1セクタ目に生成され、現在ファイル領域におけ る「#0000」~「#00FF」までの「256」セクタが空き領 域として確保された旨が示される。

【0062】 (MFディレクトリ (MF) の生成) 続い て、CPU105はMFディレクトリの生成処理を行う (図4のSP2)。まず、現在確保されている空きセク タの内、先頭の1セクタをMFディレクトリ生成用に確 保するため、システムディレクトリのTOPに記載されて いる論理アドレスを読み取る(図6参照)。この結果、 論理アドレス「#0000」を取得すると、この論理アドレ スで識別されるFAT領域の管理セクタに、最終コード である「FFFF」を登録し(図7参照)、当該論理アドレ スで識別されるセクタを上述した空きセクタのリンクか ら切り離す。これにより、論理アドレス「#0000」のセ クタをMF ディレクトリ生成用に確保することができ

【0063】続いて、256あった空きセクタの内、1 セクタをM Fディレクトリ生成用に確保した旨をシステ ル領域において、論理アドレス「#0000」~「#00FF」の 50 ムディレクトリに反映させる。即ち、MF ディレクトリ

生成用に1セクタ確保することにより、空きセクタの先頭論理アドレスは「#0000」から「#0001」へ移行し、セクタ数は1つ減少して「255」となる。従って、この旨をシステムディレクトリに登録するべく、システムディレクトリのTOPに「#0001」を、VLMにセクタ数「255」を示す「00FF」を書き込む。なお、最終セクタについては、変更がないので、BTMは「#00FF」のままである。

【0064】続いて、CPUは、確保した論理アドレス「#0000」のセクタにMFディレクトリを生成する。即ち、ディレクトリが生成された旨を示すためにFLGに「01」を登録する。なお、MFディレクトリ配下には、まだファイルが存在しないため、MFディレクトリのTOP、BTM、VLMには初期値のままである。上述した処理が行われることにより、EEPROM108のメモリマップは図7に示すような状態となる。

【0065】 (リセット応答EFディレクトリ (R-EF) の生成) 続いて、CPUはMFディレクトリ (MF) の配下にリセット応答EFディレクトリ (R-EF) を生成する処理を行う (図4のSP3)。まず、空きセクタの内、先頭の1セクタをリセット応答EFディレクトリ生成用に確保するため、システムディレクトリのTOPに記載されている論理アドレス「#0001」を読み取り、この論理アドレス「#0001」を読み取り、この論理アドレス「#0001」の管理セクタに、最終コードである「FFFF」を登録する。これにより、論理アドレス「#0001」で識別される1セクタを空きセクタのリンケージから切り離し、リセット応答EFディレクトリ生成用に確保することができる。

【0066】続いて、論理アドレス「#0001」のセクタを確保したことにより、空きセクタの先頭論理アドレス 30が「#0002」に移行し、空きセクタ数も1減少したので、その旨をシステムディレクトリに反映させるべく、システムディレクトリのTOPに「#0002」を、VLMにセクタ数「254」を示す「00FE」を登録する。なお、最終セクタについては、変更がないので、BTMは「#00FF」のままである。

【0067】続いて、CPUはリセット応答EFディレクトリをMFディレクトリ配下に生成する旨をMFディレクトリに反映させる処理を行う。具体的には、まず、MFディレクトリの配下に既にファイルが存在するか否 40 かを判断するために、MFディレクトリのBTMに「FFFF」が登録されているか否かを判断する。この結果、図7から分かるように、MFディレクトリのBTMには「FFFF」が登録されているため、CPU105は、リセット応答EFディレクトリ用に確保した1セクタの情報をMFディレクトリにそのまま反映させる。

【0068】具体的には、MFディレクトリのTOPに「#0001」を、BTMに「#0001」を、VLMに「0001」を書き込む。これにより、MFディレクトリ配下にファイルが生成され、且つ、そのファイルは論理アドレス「#0001」

のセクタに格納されていることを示すことができる。 【0069】続いて、CPUは、確保した論理アドレス「#0001」のセクタにリセット応答EFディレクトリを生成するべく、論理アドレス「#0001」のセクタのFLGに「01」を登録する。なお、リセット応答EFディレクトリ配下には、まだファイル等が存在しないため、リセット応答EFディレクトリのTOP、BTM、VLMは初期値のままである。上述した処理が行われることにより、EEPROM108のメモリマップは図8に示すような状態となる。

【0070】〈EF1の書き込み〉続いて、CPUはリセット応答EFディレクトリ(R-EF)の下にEF1を書き込む処理を行う(図4のSP4)。まず、システムディレクトリのTOPに格納されているアドレス「#0002」を読み取り、この論理アドレスを先頭論理アドレスとして、これから書き込むEF1のサイズに応じたセクタ数を確保する。ここでは、2セクタ、即ち「#0002」~「#0003」をEF1格納用に確保するべく、確保した2セクタの最終論理アドレス「#0003」に対応するFAT領域の管理セクタに、最終コードを示す「FFFF」を登録する。これにより、論理アドレス「#0002」~「#0003」で識別される2セクタを空きセクタのリンケージから切り離し、EF1格納用に確保することができる。

【0071】続いて、論理アドレス「#0002」~「#0003」の2セクタを確保したことにより、空きセクタの先頭論理アドレスが「#0004」に移行し、空きセクタ数も2減少したので、その旨をシステムディレクトリに反映させるべく、システムディレクトリのTOPに「#0004」を、VLMにセクタ数「252」を示す「00FC」を登録する。なお、最終セクタについては、変更がないので、BTMは「#00FF」のままである。

【0072】続いて、CPUはEF1をリセット応答EF配下に生成する旨をリセット応答EFディレクトリに反映させる処理を行う。具体的には、まず、リセット応答EFディレクトリのBTMに「FFFF」が登録されているか否かを判断する。この結果、図8から分かるように、BTMには「FFFF」が登録されているため、CPUは、EF1格納用に確保した2セクタの情報をリセット応答EFディレクトリにそのまま反映させる。

【0073】具体的には、リセット応答EFディレクトリのTOPに「#0002」、BTMに「#0003」、VLMに「0002」を書き込む。これにより、リセット応答EF配下にファイルが生成され、且つ、そのファイルは論理アドレス「#0002」~「#0003」のセクタに格納されていることを示すことができる。続いて、CPUは、確保した論理アドレス「#0002」~「#0003」にEF1を書き込む。上述した処理が行われることにより、EEPROM108のメモリマップは図9に示すような状態となる。

【0074】 (DF名管理EFディレクトリ (DF-DF) の生成) 続いて、CPU105はMFディレクトリ (M

(10)

F) の配下にDF名管理EFディレクトリ (DF-EF) を生成する (図4のSP5)。まず、現在確保されている空きセクタの内、先頭の1セクタをDF管理EFディレクトリ生成用に確保するため、システムディレクトリのTOPに記載されている論理アドレスを読み取る (図9参照)。この結果、論理アドレス「#0004」を取得すると、この論理アドレスで識別されるFAT領域の管理セクタに、最終コードである「FFFF」を登録し、当該論理アドレスで識別されるセクタを上述した空きセクタのリンクから切り離す。これにより、論理アドレス「#0004」のセクタをDF名EFディレクトリ生成用に確保することができる。

【0075】続いて、論理アドレス「#0004」のセクタを確保したことにより、空きセクタの先頭論理アドレスが「#0005」に移行し、空きセクタ数も1減少したので、その旨をシステムディレクトリに反映させるべく、システムディレクトリのTOPに「#0005」を、VLMにセクタ数「251」を示す「00FB」を登録する(図10参照)。なお、最終セクタについては、変更がないので、BTMは「#00FF」のままである。

【0076】続いて、CPU105はDF名管理EFディレクトリをMFディレクトリ配下に生成する旨をMFディレクトリに反映させる処理を行う。具体的には、まず、MFディレクトリのBTMに「FFFF」が登録されているか否かを判断する。この結果、図9から分かるように、MFディレクトリのBTMには「FFFF」以外の情報が登録されているため、CPUは、MFディレクトリのBTMに書き込まれている「#0001」の情報を、今回確保したセクタの最終論理アドレスである「#0004」に更新し、また、VLMの情報を「0002」に更新することにより、新たに確保したセクタ1を反映させる(図10参照)。

【0077】続いて、CPU105は、MFディレクトリのBTMの前回値(更新する前の値)である論理アドレス「#0001」で識別されるFAT領域の管理セクタに、今回、DF名管理EFディレクトリ生成用に確保したセクタの先頭論理アドレスである「#0004」を書き込む。即ち、FAT領域の論理アドレス「#0001」の管理セクタの情報を、「FFF」から「#0004」に書き換える。

【0078】これにより、図10に示すように、CPU105は、MFディレクトリのTOPに書き込まれている情報「#0001」の情報に基づいて、FAT領域を検索することにより、論理アドレス「#0001」→「#0004」と追うことができ、論理アドレス「#0001」、「#0004」の情報がMF配下に存在するということを認識することができる。

【0079】続いて、CPU105は、確保した論理アドレス「#0004」のセクタにDF名管理EFディレクトリを生成するべく、論理アドレス「#0004」のセクタのFUGに「01」を登録する。なお、DF名管理EFディレクトリ配下には、まだファイル等が存在しないため、DF 50

名管理EFディレクトリのTOP、BTM、VLMは初期値のままである。上述した処理が行われることにより、EEPROM108のメモリマップは図10に示すような状態となる。

【0080】 〈DF1ディレクトリ(DF1)の生成〉続いて、CPU105はMFディレクトリ(MF)の配下にDF1ディレクトリ(DF1)を生成する(図4のSP6)。まず、現在確保されている空きセクタの内、先頭の1セクタをDF1ディレクトリ生成用に確保するため、システムディレクトリのTOPに記載されている論理アドレスを読み取る(図10参照)。この結果、論理アドレス「#0005」を取得すると、この論理アドレスで識別されるFAT領域の管理セクタに、最終コードである「FFFF」を登録し、当該論理アドレスで識別されるセクタを上述した空きセクタのリンクから切り離す。これにより、論理アドレス「#0005」のセクタをDF1ディレ

【0081】続いて、論理アドレス「#0005」のセクタを確保したことにより、空きセクタの先頭論理アドレスが「#0006」に移行し、空きセクタ数も1減少したので、その旨をシステムディレクトリに反映させるべく、システムディレクトリのTOPに「#0006」を、VLMにセクタ数「250」を示す「00FA」を登録する。なお、最終セクタについては、変更がないので、BTMは「#00FF」のままである。

クトリ生成用に確保することができる。

【0082】続いて、CPU105はDF1ディレクトリをMFディレクトリ配下に生成する旨をMFディレクトリに反映させる処理を行う。具体的には、まず、MFディレクトリのBTMに「FFFF」が登録されているか否かを判断する。この結果、図10から分かるように、MFディレクトリのBTMには「FFFF」以外の情報が登録されているため、CPUは、MFディレクトリのBTMに書き込まれている「#0004」の情報を、今回確保したセクタの最終論理アドレスである「#0005」に更新し、また、VIMの情報を「0003」に更新することにより、新たに確保したセクタ1を反映させる(図11参照)。

【0083】続いて、CPUは、MFディレクトリのBT Mの前回値(更新する前の値)である論理アドレス「#0004」で識別されるFAT領域の管理セクタに、今回、DF1ディレクトリ生成用に確保したセクタの先頭論理アドレスである「#0005」を書き込む。即ち、FAT領域の論理アドレス「#0004」の情報を、「FFFF」から「#0005」に書き換える。

【0084】これにより、図11に示すように、CPUは、MFディレクトリのTOPに書き込まれている情報「# 0001」の情報に基づいて、FAT領域を検索することにより、論理アドレス「#0001」→「#0004」→「#0005」と追うことができ、論理アドレス「#0001」、「#000 4」、「#0005」で識別されるセクタに格納されているファイル等がMF配下に存在するということを認識するこ

とができる。

【0085】続いて、CPUは、確保した論理アドレス「#0005」のセクタにDF1ディレクトリを生成するべく、論理アドレス「#0005」のセクタのFLGに「01」を登録する。なお、DF1ディレクトリ配下には、まだファイル等が存在しないため、このディレクトリのTOP、BTM、VLMは初期値のままである。上述した処理が行われることにより、EEPROM108のメモリマップは図11に示すような状態となる。

【0086】 〈DF1のファイル名登録〉続いて、DF 10 1ディレクトリ (DF) のファイル名をDF名管理EF (DF-EF) の配下へ書き込む処理を行う (図4のSP 7)。DFには、ファイル名を付与することができる。 ここでは、DFファイルに付与されたファイル名を専用 に管理するファイルであるDF名管理EF配下に、DF 1ディレクトリに付与されたDF名を登録する処理を行

【0087】まず、システムディレクトリTOPに格納されているアドレス「#0006」を読み取り、この論理アドレスを先頭論理アドレスとして、2セクタをDF1のファイル名登録用に確保するため、この論理アドレス「#0006」から2セクタ目に当たる論理アドレス「#0007」の管理セクタに、最終コードである「FFFF」を登録する。これにより、論理アドレス「#0006」~「#0007」で識別される2セクタを空きセクタのリンケージから切り離し、DF1のファイル名登録用に確保することができる。

【0088】続いて、論理アドレス「#0006」~「#0007」の2セクタを確保したことにより、空きセクタの先頭論理アドレスが「#0008」に移行し、空きセクタ数も2減少したので、その旨をシステムディレクトリのTOPに「#0008」をせるべく、システムディレクトリのTOPに「#0008」を、VLMにセクタ数「248」を示す「00F8」を登録する。なお、最終セクタについては、変更がないので、BTMは「#00FF」のままである。

【0089】続いて、CPU105はDF1のファイル名をDF名管理EF配下に登録する旨をDF名管理EFディレクトリに反映させる処理を行う。具体的には、まず、DF名管理EFディレクトリのBTMに「FFFF」が登録されているか否かを判断する。この結果、図11から 40分かるように、DF名管理EFディレクトリのBTMには「FFFF」が登録されているため、CPUは、DF1のファイル名登録用に確保した2セクタの情報をDF名管理EFディレクトリにそのまま反映させる。具体的には、DF名管理EFディレクトリのTOPに「#0006」を、BTMに「#0007」を、VLMに「0002」を書き込む。これにより、DF名管理EF配下にDF1のファイル名が登録され、且つ、そのファイルは論理アドレス「#0006」~「#0007」のセクタに格納されていることを示すことができる。

【0090】続いて、CPUは、確保した論理アドレス「#0006」~「#0007」のセクタのFLGに「01」を登録するとともに、DFディレクトリの先頭アドレス格納領域TOP_DにDF1の先頭論理アドレス「#0005」を、またファイル名格納領域にDF1のファイル名を書き込む。なお、このファイル名登録用のセクタのレイアウトについては、図3に示した通りである。このような処理を行うことにより、DF1の先頭論理アドレス及びファイル名がDF名管理EFに登録され、以後、管理される。これにより、ファイル名によるDF検索を可能とし、DF1の先頭論理アドレス情報を得ることができ、DF1にアクセスすることができる。上述した処理が行われることにより、EEPROM108のメモリマップは図12に示すような状態となる。

【0091】〈EF2ディレクトリ (EF2) の生成〉続いて、CPUはDF1ディレクトリ (DF1) の配下にEF2ディレクトリを生成する処理を行う(図4のSP8)。まず、空きセクタの内、先頭の1セクタをEF2ディレクトリ (EF2) 生成用に確保するため、システムディレクトリのTOPに記載されている論理アドレス「#0008」を読み取り、この論理アドレス「#0008」の管理セクタに、最終コードである「FFF」を登録する。これにより、論理アドレス「#0008」で識別される1セクタを空きセクタのリンケージから切り離し、EF2ディレクトリ生成用に確保することができる。

【0092】続いて、論理アドレス「#0008」のセクタを確保したことにより、空きセクタの先頭論理アドレスが「#0009」に移行し、空きセクタ数も1減少したので、その旨をシステムディレクトリに反映させるべく、システムディレクトリのTOPに「#0009」を、VLMにセクタ数「247」を示す「00F7」を登録する。なお、最終セクタについては、変更がないので、BTMは「#00FF」のままである。

【0093】続いて、CPU105はEF2ディレクトリ (EF2)をDF1ディレクトリ (DF1)配下に生成する旨をDF1ディレクトリに反映させる処理を行う。具体的には、まず、DF1ディレクトリのBTMに「FFFF」が登録されているか否かを判断する。この結果、図12から分かるように、DF1ディレクトリのBTMには「FFFF」が登録されているため、CPUは、EF2ディレクトリ生成用に確保した1セクタの情報をDF1ディレクトリにそのまま反映させる。具体的には、DF1ディレクトリのTOPに「#0008」を、BTMに「#0008」を、VIMに「0001」を書き込む(図13参照)。これにより、DF1配下に下位ディレクトリが生成され、且つ、その下位ディレクトリは論理アドレス「#0008」のセクタに格納されていることを示すことができる。

【0094】続いて、CPU105は、確保した論理アドレス「#0008」のセクタにEF2ディレクトリを生成するべく、論理アドレス「#0008」のセクタのFLGに「0

(12)

21

1」を登録する。なお、EF2ディレクトリ配下には、まだファイル等が存在しないため、EF2ディレクトリのTOP、BTM、VLMは初期値のままである。上述した処理が行われることにより、EEPROM108のメモリマップは図13に示すような状態となる。

【0095】〈EF2の書き込み〉続いて、CPUはEF2ディレクトリ(EF2)の下にEF2を書き込む処理を行う(図4のSP9)。まず、システムディレクトリのTOPに格納されているアドレス「#0009」を読み取り、この論理アドレスを先頭論理アドレスとして、これから10書き込むEF2のサイズに応じたセクタ数を確保する。ここでは、2セクタ、即ち「#0009」~「#000A」をEF2格納用に確保するべく、確保した最終論理アドレス「#000A」に対応するFAT領域の管理セクタに最終コードを示す「FFF」を登録する。これにより、論理アドレス「#0009」~「#000A」で識別される2セクタを空きセクタのリンケージから切り離し、EF2格納用に確保することができる。

【0096】続いて、論理アドレス「#0009」~「#000 A」の2セクタを確保したことにより、空きセクタの先頭論理アドレスが「#000B」に移行し、空きセクタ数も2減少したので、その旨をシステムディレクトリに反映させるべく、システムディレクトリのTOPに「#000B」を、VLMにセクタ数「245」を示す「00F5」を登録する。なお、最終セクタについては、変更がないので、BT Mは「#00FF」のままである。

【0097】続いて、CPU105はEF2をEF2ディレクトリ配下に生成する旨をEF2ディレクトリに反映させる処理を行う。具体的には、まず、EF2ディレクトリのBTMに「FFFF」が登録されているか否かを判断する。この結果、図13から分かるように、BTMには「FFFF」が登録されているため、CPUは、EF2格納用に確保した2セクタの情報をEF2ディレクトリにそのまま反映させる。

【0098】具体的には、EF2ディレクトリのTOPに「#0009」、BTMに「#000A」、VLMに「0002」を書き込む(図14参照)。これにより、EF2ディレクトリ配下にファイルが生成され、且つ、そのファイルは論理アドレス「#0009」~「#000A」のセクタに格納されていることを示すことができる。続いて、CPU105は、確保40した論理アドレス「#0009」~「#000A」にEF2を書き込む。上述した処理が行われることにより、EEPROM108のメモリマップは図14に示すような状態となる。

【0099】続いて、CPUは同様の方法で、DF1ディレクトリ (DF1) の配下にDF2ディレクトリ (DF2) を生成する処理 (図4のSP10)、DF2のファイル 名をDF名管理EFディレクトリ (DF-EF) の配下へ書き込む処理 (図4のSP11)、DF2ディレクトリ (DF2) の配下にEF3ディレクトリ (EF3) を生成する 50

処理 (図4のSP12)、EF3ディレクトリ (EF3) の下にEF3を書き込む処理 (図4のSP13)、DF2ディレクトリ (DF2) の配下にEF4ディレクトリ (EF4) を生成する処理 (図4のSP14)、EF4ディレクトリ (EF4) の下にEF4を書き込む処理 (図4のSP15)を行う。この結果、EEPROM108のメモリマップは図15に示すような状態となる。

【0100】(5) ATR情報について

一般的にICカードは機種によりその伝送プロトコルが 異なるので、ICカードは伝送プロトコル等を外部装置 であるカードR/Wに知らせるためリセット信号による リセット解除を認識後、ATR (Answer To Reset) と 称する初期応答データをカードR/Wに出力する。その 後、ICカードは命令待ち状態になる。この場合、初期 応答データは、ICカードの伝送プロトコル使用情報と ICカード固有の情報とから構成されており、ICカー ドの製造時に固有パラメータとしてROMに予め登録されている。

【0101】ところで、ICカードを利用者に対して発行した後に、外部装置等のアプリケーションが変更された場合等には、ICカード内に登録されたATR情報を変更する必要性が生じる。この場合、ROM内に書き込まれたATR情報を更新することは不可能であるため、情報の書き換えが可能であるEEPROM内の特定のファイル内に変更後のATR情報を格納し、以降、外部装置からリセット信号を受け付けたときには、EEPROM内の特定ファイル内に登録されたATR情報を出力する。

【0102】ここで、本発明の一実施形態に係るEEP ROMのメモリ階層構造を図16に示す。ここで、リセ ット応答EFは、ATR情報書き込み専用ファイルとし てEEPR OM内に設けられたファイルである。また、 認証EFには、リセット応答EF内のデータを書き換え る際に必要となる認証キーの情報等が格納されている。 なお、以下説明する本実施形態に係るATR情報書き換 え処理は、上述した接触型 I Cカード、非接触型 I Cカ ード、複合型ICカードのいずれにも適用することがで きる。なお、以下の説明におけるEEPROMとは、各 種ICカードのICチップ内に実装されているEEPR OMのことであり、例えば、接触型ICカードに本発明 を適用する場合には、図21に示したEEPROM10 8のことであり、非接触型 I Cカードに本発明を適用す る場合には、EEPROM114のことである。同様 に、複合型 I Cカードでは、EEPROM 1 2 3 のこと

【0103】以下、上述したようなファイル構造を持つ EEPROMのリセット応答EFに対して、新規にAT R情報を書き込む処理について図17を参照して説明する。なお、前提としてEEPROMのリセット応答EF は、初期状態であるものとする。

24

【0104】まず、外部装置はICカードを起動させるためにリセット信号を出力する(図17のステップSP101)。これにより、リセット信号を受け取ったICカード内のCPUは、ROM又はEEPROM内に格納されているATR情報の読み出し処理を行い、読み出したATR情報を外部装置へ送信する(ステップSP102)。

【0105】ここで、上記ATR情報の読み出し処理について図18を参照して説明する。まず、CPUは、EEPROM内のリセット応答EFに付加されているID 10名に基づいて、リセット応答EFを検索する(図18のステップSP201)。続いて、リセット応答EFのデータ部が初期状態であるか否かを判断する。(ステップSP202)。この結果、リセット応答EFのデータ部は初期状態(例えば、データが全て「F」の状態)であるので、CPUは、ROM内に登録されているATR情報を読み出し、読み出したATR情報を出力する(ステップSP203、図17のステップSP102)。

【0106】続いて、外部装置はATR情報を受け取ると、続いて、リセット応答EFを選択する指示をICカ 20 ードに対して出力する(図17のステップSP103)。この指示を受けて、ICカード内のCPUはリセット応答EFを選択し、その旨を外部装置へ通知する(ステップSP104)。続いて、外部装置は、ICカードに対して新たなATR情報の書き込み要求を出力する。この要求を受けたICカード内のCPUは、該要求と共に受け取ったATR情報のをステップSP104において選択したリセット応答EFディレクトリの配下に書き込む処理を実行する(上述の〈EFデータ1等の書き込み〉参照)。これにより、リセット応答EFディ 30レクトリ配下に新たなATR情報のを書き込むことが可能となる

【0107】次に、上述したような処理が行われることにより、EEPROM内のリセット応答EFに書き込まれたATR情報②を更に新しいATR情報②に書き換える処理について図19を参照して説明する。まず、外部装置はICカードを起動させるためにリセット信号を出力する(図19のステップSP111)。これにより、リセット信号を受け取ったICカード内のCPUは、図17に示した処理を行うことにより、ROM内及びEE 40PROMのリセット応答EF内に格納されているATR情報①を読み出し、このATR情報①を外部装置へ出力する(ステップSP112)。

【0108】続いて、外部装置はリセット応答EFを選択する旨の指示を出力する(ステップSP113)。これにより、ICカード内のCPUはリセット応答EFを選択し、その旨を外部装置へ通知する(ステップSP114)。続いて、外部装置はリセット応答EFのデータ部に格納されているATR情報①の読み出し要求を出力する(ステップSP115)。これにより、ICカード 50

のCPUはリセット応答EFのデータ部からATR情報 ①を読み出し、出力する(ステップSP116)。続いて、外部装置はATR情報 ②の書き込み要求を出力する(ステップSP117)。書き込み要求を受け取ったICカードのCPUは、鍵の認証処理を行った後でなければ、書き込みを許可できないため、書き込み要求を拒否する旨の情報、即ち、書き込み拒否のエラー通知を外部装置へ出力する(ステップSP118)。

【0109】続いて、外部装置はATR情報②の書き換え要求を出力する(ステップSP119)。書き込み要求を受け取ったICカードのCPUは、鍵の認証処理を行った後でなければ、書き換えを許可することができないため、書き換え要求を拒否する旨の通知、即ち書き換え拒否のエラー通知を出力する(ステップSP120)。続いて、外部装置は、自己が保有している認証鍵(KEY1)を発行(出力)する(ステップSP121)。この認証鍵の情報を受け取ったICカードのCPUは、自己が有している認証キーの情報と照合を行い、両者が一致、又は正当な組み合わせであることを確認すると、書き換えアクセス許可をRAMに記憶し、書き換え要求を許可する旨を外部装置へ出力する(ステップSP122)。

【0110】続いて、書き換え要求を許可する旨の通知を受けた外部装置は、ATR情報②の書き換え要求を出力する(ステップSP123)。これにより、ICカードのCPUは、リセット応答EFのデータ部に格納されているATR情報②をATR情報②に書き換える(ステップSP124)。上述したような通信が外部装置とICカードとの間で行われることにより、リセット応答EF内のATR情報を書き換えることが可能となる。

【0111】以上、この発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。

[0112]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のICカードによれば、不揮発性メモリ内に、新たな初期応答データを書き込むための初期応答データ書き込み専用ファイルを設けるので、ICカード発行後において、ROM内に予め登録されている初期応答データを変更する必要がある場合には、書き換え可能な不揮発性メモリに新たな初期応答データを書き込むことにより、初期応答データの更新を行うことができる。これにより、外部機器に対して変更後の即ち、最新のICカードの初期情報を通知することが可能となる。また、初期応答データを専用に格納する初期応答データ書き込み専用ファイルを設けることにより、新たな初期応答データを容易に読み出すことができ、迅速な外部装置とのデータ通信を実現することができる。

【0113】また、請求項2に記載のICカードによれ

(14)

ば、外部からリセット信号を受信した場合に、初期応答データ書き込み専用ファイル内に新たな初期応答データ書き込み専用ファイル内に新たな初期応答データ書き込み専用ファイル内に新たな初期応答データが書き込まれている初期応答データと初期応答データ書き込み専用ファイル内の新たな初期応答データとを読み出して、外部に出力する。このようにROM及び不揮発性メモリの双方から初期応答データを読み出すので、初期応答データ書き込み専用ファイルには、元の初期応答データに対して変更がりませた部分だけを登録しておけばよい。これにより、初期応答データ用ファイルに登録するデータ量を軽減させることができ、初期応答データの読み出し処理を迅速に行うことが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施形態に係るICカードのファイル階層構造を示す図である。

【図2】 ディレクトリを生成するセクタのレイアウト の一例を示す図である。

【図3】 DFのファイル名を格納するセクタのレイア 20 ウトの一例を示す図である。

【図4】 図1に示したファイル階層構造をより具体的に示した図である。

【図5】 初期状態におけるEEPROMのメモリマップを示す図である。

【図6】 システムディレクトリを生成したときのEE PROMのメモリマップを示す図である。

【図7】 MFを生成したときのEEPROMのメモリマップを示す図である。

【図8】 リセット応答EFディレクトリを生成したと 30 きのEEPROMのメモリマップを示す図である。

【図9】 EF1を格納したときのEEPROMのメモリマップを示す図である。

【図10】 DF名管理EFディレクトリを生成したと きのEEPROMのメモリマップを示す図である。

【図11】 DF1ディレクトリを生成したときのEE PROMのメモリマップを示す図である。

【図12】 DF1のファイル名を格納したときのEE PROMのメモリマップを示す図である。

【図13】 EF2ディレクトリを生成したときのEE 40 PROMのメモリマップを示す図である。

【図14】 EF2を格納したときのEEPROMのメ モリマップを示す図である。

【図15】 図1に示すファイル階層構造をEEPRO Mに作成したときのメモリマップを示す図である。

【図16】 本発明の一実施形態に係るICカードのEEPROMのメモリ階層構造を示す図である。

*【図17】 EEPROMのリセット応答EFに対して、新規にATR情報を書き込む処理について示したフローチャートである。

【図18】 ATR情報の読み出し処理について示したフローチャートである。

【図19】 ATR情報^①を更に新しいATR情報^②に 書き換える処理について示したフローチャートである。

【図20】 代表的な接触型ICカードの概観図である。

【図21】 接触型ICカードの電気構成図である。

【図22】 代表的な非接触型 I Cカードの概観図である。

【図23】 非接触型ICカードの電気回路構成を示す 図である。

【図24】 複合型ICカードの電気回路構成を示す図である。

【図25】 複合型 I Cカードの構造を示す図である。

【図26】 複合型 I Cカードの平面図である。

【図27】 複合型ICカードにおけるコイルの複合型ICカード内部に於ける実装位置を示す図である。

【図28】 外部装置が放射する高周波電磁界の周波数が、図39及び図40の場合に比べて1桁乃至2桁低い場合に適したコイルの巻き方を示した図である。

【図29】 代表的なICカードシステムの構成を示す 図である。

【図30】 接触型のインターフェースが使用される場合のICカードとカードR/Wとの通信を説明するための図である。

【図31】 非接触型のインターフェースが使用される場合のICカードとカードR/Wとの通信を説明するための図である。

【図32】 ICカードの製造から発行までの過程を示す図である。

【図33】 原国際規格ISO/IEC7816シリーズにより規定されている基本的なファイル階層構造を示す図である。

【符号の説明】

Y セクタ (区画)

F 管理セクタ (管理区画)

10 105, 111, 121 CPU (中央処理装置)

106, 112, 122 ROM

107, 113, 124 RAM

108, 114, 123 EEPROM

101, 125 端子電極

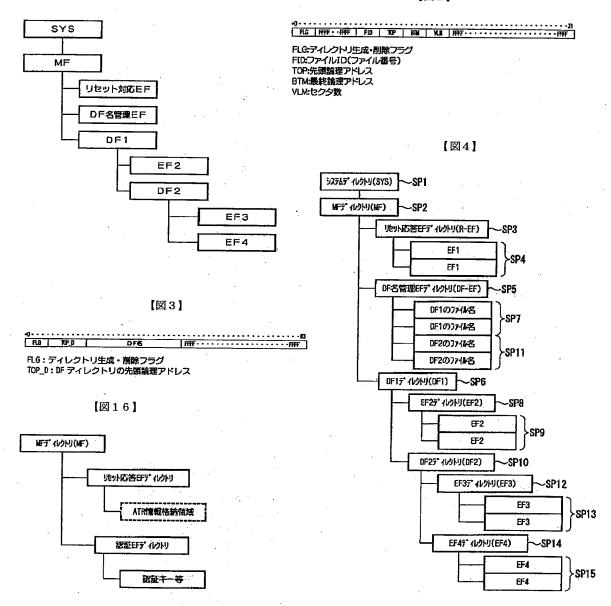
116, 126 共振回路部

115, 127 RF回路

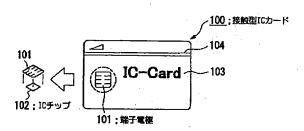
102, 110 ICチップ

【図1】

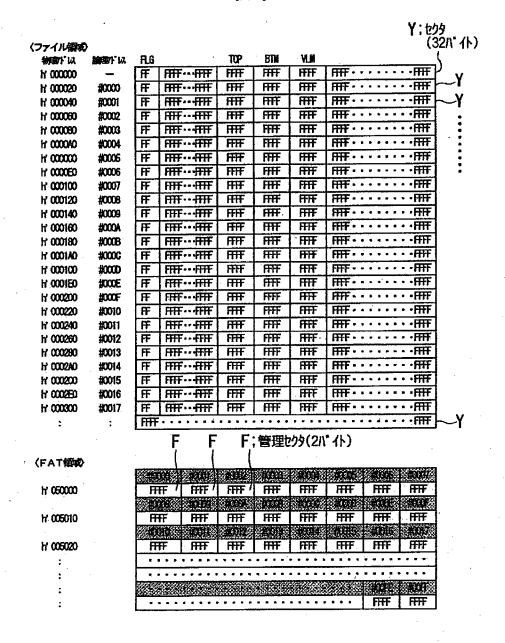
【図2】

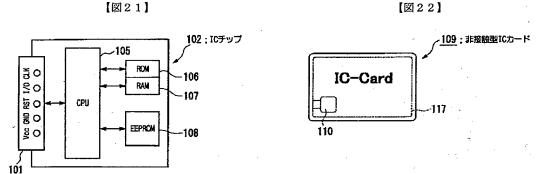


【図20】



【図5】





【図6】

	物理が以	が一個	FLG		TOP	BTM	VLM	
sys	H 000000	~	01	XX XXX	#0000	#00FF	0100	XXXX システムトラック/青報 XXXX
¥F≫	H 000020	#0000	FF		FFFF	FFFF	FFFF	
	H 000040	#0001	FF		FFFF	नान	FFFF	
	H 000060	#0002	FF		FFFF	FFFF	FFFF	
	H 000080	#0003	F	·	FFFF	FFFF	FFFF	
	H 00000A0	#0004	FF		FFF	FFFF	FFFF	
	H 000000	#0005	Ή		FFFF	FFFF	FFFF	
	H 0000E0	#0006	FF		FHFF	FFFF	FFFF	
	H 000100	#0007	귀		FFFF	FFFF	FFFF	
	H 000120	#0008	FF		FFFF	FFFF	7777	
	h 000140	#0009	FF		FFFF	FFFF	ननन	
	J. 000160	#000A	FF		FFFF	सम	ननन	
	H 000180	#000B	FF		FFFF	FFFF	FFFF	
	H 0001Y0	#000C	FF		FFFF	7177	ननन	
	H 000100	#000D	FF		FFFF	FFFF	FFFF	
	H 0001E0	#000E	FF		FFFF	FFFF	FFFF	
	h 000200	#000F	H		FFFF	FFFF	FFFF	
	H 000220	#0010	H		FHFF	FFFF	नास	
	H 000240	#0011	H		FHF	FFFF	FFFF	
	h 000260	#0012	FF		FFFF	नास	FFFF	
	h' 000280	#0013	FF		FFFF	7177	FFFF	
	H 0002A0	#0014	FF		FHF	FFFF	FFFF	
	H 000200	#0015	FF		FIFF	HHF	FFFF	
	h 0002E0	#0016	F		FHF	सम	FFFF	
	JA 000300	#0017	FF		FFFF	FFFF	FFFF	
	:		m.					
•	. :	: {	Æ.					
	:	: [- 1111		• • • •			***************************************

h 050000

H 005010

h 005020 :

+0011	*0012	+0013	+0014	*0015	+0016	*0017	*001
#0010	#0011	#0012	#0013	#0014	#0015	#0016	#001
+0009	*000A	*000B	*000C	+0000	+000E	*000F	*001
#0000	#0009	#000A	#0008	#0000	#0000	#1000E	#000
+0001	+0002	+0003	*0004	*0005	*0006	*0007	*000

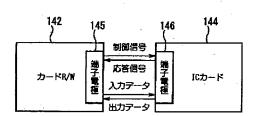
【図7】

	物理ドル	論理ドル	FLG		TOP	BTM	VLM	·
SYS	H 0000000	_	01	XXXXXX	#0001	#00FF	00FF	XXX システムトラックが育業 XXXX
¥F≫	H 000020	#0000	01	XX XXXX	FFFF	777	FFFF	1000X NF トラック情報 1000X
	H 000040	#0001	FF		FFFF	HH	नान	
	h 000060	#0002	FF		FFFF	FFFF	FFFF	1
	H 0000080	#0003	·FF		FFFF .	HHF.	FFFF	
	H 00000A0	#0004	FF		FFFF	FFFF	FFFF	
	H 000000	#0005	FF		FFFF	मरन	FHF	
	H 0000E0	#0006	FF		FITT	H	FFF	
	H 000100	#0007	FF		FFFF	111	FFF	
	H 000120	#0008	FF		177	1171	##	
	H 000140	#0009	FF		FFFF	नसन	FFFF	
	H 000160	#000A	FF		1111	447	##	
	H 000180	#000B	FF		FFFF	FFFF	FFFF	
	H 0001A0	#000C	Ŧ		FFFF	FFFF	FFFF	
	H 000100	#000D	FF		FIFF	FFFF	FHF	
	H 0001E0	#000E	FF		111 1	1111	FFFF	
	H 000200	#000F	FF.		FFFF	FFFF	FFFF	
	h 000220	#0010	FF		FFFF	FFFF	FFFF	
	H 000240	#0011	FF.		FFFF	FFFF	FFFF	
	H 000260	#0012	FF		1111	7177	FFFF	
i.	H 000280	#0013	FF		FFFF	1 11	ननन	
	H 0002A0	#0014	H		नमन	FFFF	FFFF	
	H 000200	#0015	FF		FFFF	FFFF	FFFF	
	H 0002E0	#0016	FF		FFFF	FFFF	FHF	
_	H 000300	#0017	FF		FFFF	FFFF	FFFF	
	:	:	FFFF					•••••• ••
	:	:	FFFF				÷, -	
	:	:	FFFF					

H 050000 H 005010 H 005020

#0000	#0001	#0002	#0003	#6004	#0005	#0006	#0007
FFFF	+0002	+0003	*0004	+0005	*0006	+0007	+0008
#X008	#0000	#000A	#000B	#0000	#0000	#000E	#000F
+0009	+000A	+000B	*000C	*0000	*000E	*000F	*0010
#0010	#0011	#0012	#0013	#0014	#0015	#0016	#0017
*0011	*0012	+0013	+0014	+0015	+0016	+0017	*0018
			• • • • •				• • •
• • • •							
	474\$ % ·				6 . 6	#OOFE	#COFF
						*00FF	FFFF

【図30】



【図8】

【図32】

-SP42

-SP43

ICカード製造

ICカード発行

ICカード使用

	物理ドル	神理がい	FLG		TOP	BTM	VLM.	
SYS	H 0000000		01	XX XXXX	#0002	#00FF	00FE	XXXX 解報 XXXX
₩≫	H 000020	#0000	01	XX · XXXX	#0001	#0001	0001	XXXX 編F トラッ分育報 XXXX
R -IJ F	H 000040	#0001	01		FFF	FFFF	FFFF	
	H 0000060	#0002	FF		FFFF	FFF	FFFF	. ,
	H 0000090	#0003	FF		HH.	FFFF	FFFF	
	H 0000A0	#0004	FF		FFF	HH	FFFF	
	H 000000	#0005	FF		ĦĦ	सम	FFFF	1.00
	H 0000E0	#0006	FF		FFF	HH	FFFF	
	H 000100	#0007	FF		FFFF	FFFF	FFFF	, a
	H 000120	#0008	FF		HH.	HH	FFFF	
	H 000140	#0009	FF		FFF	FFFF	FFFF	
	H 000160	#000A	FF		FFF	FFF	FFFF	
	H 000180	#000B	FF		FFF	HH.	FFFF	
,	H 0001A0	#000C	FF		FIF	सस	FFFF	
	H 000100	#000D	FF		HHF	FFF	FFFF	
	H, 0001E0	#000E	FF		FFF	HHF	FFFF	
	H 000200	#000F	FF	-	##	FFF	FFFF	
	H 000220	#0010	FF .		111	HH.	FHF	
	H 000240	#0011	FF	_	HH.	FFFF	1111	No. Age
	H 000260	#0012	FF		HH.	HHF.	FFFF	
	H 000280	#0013	FF		HH	HH	FFFF	
	H 0002A0	#0014	FF		HH.	FFF	FFFF	
	h 000200	#0015	FF		HH	FFF	FFFF	3.
	H 0002E0	#0016	F		HHF.	HH	FFFF	
	h' 000300	#0017	FF		FFF	FFFF	FIFF	71.5
	:	:	441					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	:	:	FFFF ·				• • • •	
	:	:	1111					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

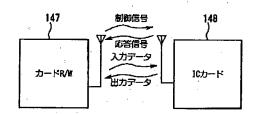
H 050000

H 005010

H 005020

Lassific			· · · · · ·				HOTE
+0011	*0012	*0013	+0014	+0015	*0016	*0017	+0018
10010	#0011	#0012	10013	10014	#0016	#0016	#0017
*0009	*000A	+000B	*000C	+000D	*000E	*000F	+0010
0008	#0009	#000A	#000B	#000C	#0000	#COOE	HOOOF
FFFF	नान	*0003	+0004	*0005	+0006	*CCOO7	#0008
ALLU .	#0001	#0002	#1000	#0004	10005	#0006	#0007

【図31】



【図9】

	物理ドル	論事が以	FLG		TOP	BTM	VLM		
SYS	H 0000000	· –	01	XX XXXX	#0004	#00FF	OOFC	XXXX システムトラック情報	XXXX
₩×	H 000020	#0000	01	XX XXXX	#0001	#0001	0001	XXXX NF ドラッケ作権	XXXX
R-EF	H 000040	#0001	01	XX XXX	#0002	#0003	0002	XXXX 日 ラック情報	XXXX
	H 0000060	#0002		·		EFI			
	H: 0000080	#0003				E F1			
	H 00000A0	#0004	FF		FFF	HH.	HH.		,
	H 000000	#0005	FF		4411	FFF	FFFF		
_	H 0000E0	#0006	FF ·		FFFF	FFFF	FFFF		
	H 000100	#0007	FF	,	ननन	FFFF	1111		
	H 000120	#0008	FF		FFFF	FFF	HH.		
	H 000140	#0009	FF	, , ,	FFFF	FFF	ननन		
	H 000160	#000A	FF		1111	#	ननन		
	H 000180	#000B	FF		FFF	FFFF	FFFF		
	H 0001A0	#000C	FF		FFF	FFF	FFFF		
	H 000100	#000D	FF		HH	FFFF	FFF		
	H 0001E0	#000E	FF		FFFF	FFF	1111		
	H 000200	#000F	FF		FFFF	माम	HHF.		
	H 000220	#0010	FF	1.5	FFFF	FFFF	FFF		
	H 000240	#0011	FF	4 1	FFFF	FFF	HTFF.		
	H 000260	#0012	FF		FIFE	FFFF	FFF	<u> </u>	
	H 000280	#0013	FF	5_1	FFFF	FFF	FFFF		
	h 000540	#0014	FF		FFFF	FFF	FFFF		
	H 000200	#0015	FF		मम	FFF	FFFF		
	H 0002E0	#0016	FF		FFF	FFF	FFFF		
	H 000300	#0017	FF		FFF	HIF	FFFF		•
	:	:	FFFF	<i></i>		• • • •			FFF
	:	:	FFFF						FFF
	:	:	FFF		<i>.</i> .			F	FFF

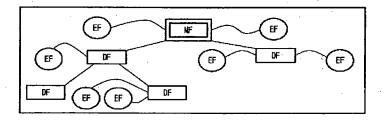
w	WINN	

h 005010

H 005020

			4.00		e e Per () ()	#00FE	#00FT
• • •							
+0011	*0012	+0013	+0014	*0015	+0016	*0017	+001
#010	10011	#0012	#0013	#0014	H0015	#0016	#001
*0009	+000A	+000B	*000C	*000D	*000E	*000F	+001
#0008	#0009	#0004	10006	¥000	#000D	#XXE	#000
FFFF	/ IIII	+0003	HHT.	*0005	*0006	+0007	+000
#0000	#,001	#UZ		XU 4	#0005	#3006	#000

[図33]



【図10】

	物理が以	論理が以	FLG		TOP	BIM	VLM	
SYS	It 000000	_	01	XX XXXX	#0005	#00FF	OOFB	XXXX システムトラックが自転 XXXX
¥	H 000020	#0000	01	XX XXX	#0001	#0004	0002	1000X MF 1ラック情報 2000X
R-EF	H 000040	#0001	01	XXXXXX	#0002	#0003	0002	XXXX EF Iラック情報 XXXX
	H 000060	#0002				EF	1	
	H 000080	#0003				EF	1	
DF-EF	H CODOAD	#0004	01	XX XXX	FFFF	HIT	FFFF	XXXX IF 15ック情報 XXXX
	H 000000	#0005	FF		FFF	FFF	FHFF	
	H 00000ED	#0006	FF		FFF	FFFF	HIF	
	H 000100	#0007	FF		HH	FFFF	FFFF	
	ir 000120	#000B	FF		सम	FFFF	FFFF	
	H 000140	#0009	FF		FFF	ननन	FFFF	
	H 000160	#000A	FF	-	FFFF	सस	FFFF	
	fr 000180	#000B	FF	-	मम	FFFF	FFFF	
	H 0001A0	#000C	FF		सस	HH	7771	
•	H 000100	#0000	F	_	1111	FFFF	HHF	
	H 0001E0	#000E	Æ		777	FFFF	FFFF	
	H 000200	#000F	FF		HH.	नम	नाम	
	H 000220	#0010	FF		1111	नम	FFFF	
	H 000240	#0011	FF		TFFF	1111	FFF	
	H 000260	#0012	Ŀ		HH	सम	FFFF	4. 10
	H 000280	#0013	F		FHT	HH	FFFF	
-	H 0002AD	#0014	뜌		HH.	FFFF	FFFF	-
	H 000200	#0015	FF		HTH	FFFF	FFFF	
	H 0002E0	#0016	ᄔ		HTF	HTF	7717	
	H 000300	#0017	FF		HH	FFFF	FFFF	
	:	:	m.					·······································
•	:	:	HH.					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•	., :	:	m.					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

h 050000 h 005010 h 005020

#0000	#0001	#0002	#0003	#0004	#0005	#0006	#0007
नान	#0004	*0003 /	FFFF	FFFF	*0006	+0007	*000E
#0008	#0000	10004	#0008	#000C	#000D	#000E	#C00F
+0009	*000A	+000B	*000C	*000D	*000E	*000F	*0010
#0010	#0011	#0012	#0013	#0014	#0015	#0016	#0017
*0011	*0012	*0013	+0014	*0015	+0016	*0017	+0018
	· · · · · · ·						
						HOOFE	HOOFT
						+ ΩF	FFF

【図11】

	物理が以	神理が以	FLG	•	TOP	BTM	MLIV	
SYS	h 000000		. 01	XX · · · XXXX	#0006	#00FF	COFA	XXXX システムトラック付算報 XXXX
₩ ≫	H 000020	#0000	01	XX • • • XXXX	#0001	#0005	0003	XXXX MF トラック/解板 XXXXX
R -EF	H 000040	#0001	01	XX XXX	#0002	#0003	0002	XXXX EFFy/分解 XXXX
	H 000060	#0002				EF	1	
	H 000080	#0003				EF	1	
DF-EF	H 00000NO	#0004	01	XX XXX	FFF	E	HHF	XXXX IT F57/mm報 XXXX
DF1	H 000000	#0005	01	XX XXX	44	FFFF	HHF	XXXXX DF 155/分費報 XXXX
	₩ 0000Œ0	#0006	FF		FFF	FFFF	ITT F	
	H 000100	#0007	FF		HTT.	++++	FFFF	
	h 000120	#0008	FF		HH.	FFFF	HHF	
	H 000140	#0009	FF		FFFF	FFFF	FFFF	
	H 000160	#000#	FF		HH	FFFF	HH	
	H 000180	#000B	FF		FFFF	FFFF	FFFF	
	H 0001A0	#000C	FF		FFF	FFFF	FFFF	
	h 000100	#000D	FF		HTF	FFFF	HH	
	H 0001E0	#000E	FF		HH	FFFF	H-H-	* .
	H 000200	#000F	FF		HH.	FFFF	H-H-	
	h 000220	#0010	FF		मान	FFFF	HTT	
	H 000240	#0011	FF		FFFF	FFFF	HH	:
	H 000260	#0012	FF		FIF	FFFF	H-H-	
	h 000280	#0013	FF		FFFF	FFFF	H TT	
	H 0002A0	#0014	FF		HH.	FFFF	HH	
	H 000200	#0015	FF		FFF	FFFF	HTT	
	H 0002E0	#0016	F		FFF	FFFF	FFF	
	H 000300	#0017	FF		FFF	FFFF	FFF	
	:	:	FFFF-					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	:	:	FFFF			• • • •	• • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	:	:	FFFF	• • • • • •		• • • •	*.* * *	

H	050000
h	005010
	:
H	005020
	:

#000	10001	#0002	#0003	#0004	#0005	#000	#0007
FFFF	#0004	*0003	FFFF	+0005	FFFF	*0007	*0008
#0008	#0009	#XXX	#0008	#000G	#0000	#000E	#000F
*0009	+000A	*000B	*000C	*C000	+000E	*000F	+0010
#0010	#001	#XXX12	#0013	#0014	#0015	#0016	#0017
+0011	+0012	*0013	*0014	*0015	+0016	+0017	+0018
• • •						,	• • •
		- 6	• • • •			#00FE	HOOFF
						*00FF	FFFF

【図12】

	物理ドル	論理ドル	FLG		TOP	BTM	VLN	
SYS	h 000000	·	01	XXX···XXX	#0008	#00FF	00F8	XXXX システムトラック情報 XXXX
嵋≫	H 000020	#0000	01	XX XXX	#0001	#0005	0003	XXXX MF トラック情報 XXXX
R-EF	h 000040	#0001	01	XXXXX · · · XXXX	#0002	#0003	0002	XXXX EF トラッ//青報 XXXX
	H 000060	#0002				EF	1	
	H 000080	#0003				EF	1	and the second
DF-EF	H 0000A0	#0004	01	XX XXXX	#0006	#0007	0002	XXXX IF I ラッ分育級 XXXX
DF1	H 000000	#0005	01	XX XXXX	FHF	FHF	FFFF	XXXX DF Fラッケナ XXXX
	h 0000E0	#0006	01	#0005		D	FI のファ	
	H 000100	#0007	01			D	F1 のファ	1几名
	H 000120	#0008	FF		FFFF	FFFF	ननन	
• •	H 000140	#0009	FF		ननन	ननन	FFFF	
	h' 000160	#000A	FF		FFFF	FFFF	FFFF	
	h' 000180	#000B	FF		FFFF	FFFF	FFFF	
	H 0001A0	#000C	FF.		FFFF	FFFF	FFFF	
	H, 000100	#000D	FF		FFFF	FFFF	FFF	
	H 0001E0	#000E	Ή		ननन	FFFF	FFFF	
	ਮ 000200	#000F	FF		FFFF	FFFF	FFF	
	h' 000220	#0010	FF		FFFF	FFFF	FIFF	
	h 000240	#0011	FF.	-	ननन	FFFF	FIFF	
	h 000260	#0012	FF		ननन	FFFF	FFFF	
	h 000280	#0013	F		FFFF	HH.	FFFF	
	h' 0002A0	#0014	F		HH	FFFF	FFFF	
	ਮ 000200	#0015	F		FFFF	FFFF	नमन	
	₩ 0002E0	#0016	FF		FFFF	FFFF	FFFF	
	H 000300	#0017	FF		FFFF	FFFF	FFFF	
	:	:	ffff ·					
	: ,	:	नन्त					नसारकारकार
	:	:	FFFF ·					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

h' 050000 h' 005010 h' 005020

#0000	\$ 0001	#0002	#0000	#0004	#0005	#0006	#0007
1111	#0004	+0003	FIFE	+0005	FFFF	*0007	FFFF
#0008	#0009	#000A	#0008	#000C	#000D	#000E	#000F
*0009	*000A	*000B	*000C	+0000	*000E	+000F	+0010
#0010	#0011	#0012	#0013	#0014	#0015	#0016	#0017
+0011	*0012	+0013	+0014	+0015	+0016	+0017	#001B
					• • • •	,	
				· · · · ·	• • • •		
• • •	• • • • •			11A 7 9-4		#00FE	#00FF
						+00FF	7777

【図13】

	物理が以	調動がな	FLG		TOP	BTM	VLM	
SYS	K 0000000	-	01	XX XXX	#0009	#00FF	00F7	XXXX システムトラック情報 XXXX
MF	h' 000020	#0000	01	XX XXXX	#0001	#0005	0003	XXXX MF I 57/竹箱 XXXX
R-EF	H 000040	#0001	01	XX • • • XXXX	#0002	#0003	0002	XXXX EF I 为州輔 XXXX
	h 000060	#0002				EF	1	
	H 000080	#0003				EF	1	
DF-EF	H 00000AD	#0004	01	XX XX	#0006	#0007	0002	XXXX FFin/fine XXXX
DF1≫	H 0000000	#0005	01	XX XXX	#0008	#0008	0001	XXXX DF トラック作権 XXXX
	H 0000ED	#0006	01	#0005		DF10	ファイル	名
	h' 000100	#0007	01			DF1.0	フファイル	名
EF2	H 000120	#0008	01	XX XXX	H	HH	HII	-
	h 000140	#0009	FF		HH.	PITT	HH	
	H-000160	#000A	F		FFFF	HHF	HH	`
	H 000180	#000B	FF		HH	HHF	HH	
	H 0001AD	#000C	HF		HHF	HH.	HIT	
	H 000100	#0000	FF		ATT.	H	H	
	H 0001E0	#000E	FF		HH	HH	HH	
	H 000200	#000F	FF		H	HTT	HHF	
	H 000220	#0010	IF	4.5	HH	FFFF	HHF	
	h' .000240	#0011	FF		HH	HH	HIF	
	H 000260	#0012	IF		Ш	HH	HH	
	H 000280	#0013	F		HH-	FFFF .	-111	
	h' 0002AD	#0014	F		HH	IIIT	HH	
	h 000200	#0015	F		rm	FFFF	FFFF	:
	H 0002E0	#0016	IF		FHF	FFFF	FFFF	
	H 000300	#0017	Ħ		FHF	HHF '	FFF	
	•:	:	HHF					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	:	;	HHF					· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	:	:	FFF					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

H 050000

H 005010

H: 005020

	198 and 198						
#0000	#0001	#0002	#0003	#0004	#0005	#0006	#0007
FFFF	#0004	*0003	HH	*0005	FFFF	+0007	HH
#0008	#0009	#000A	#000B	#000C	#000D	#000E	#000F
FFFF	*000A	*000B	*000C	+000D	+000E	+000F	+0010
#0010	#0011	#0012	#0013	#0014	#00/15	#0016	#0017
+0011	+0012	+0013	*0014	+0015	*0016	+0017	*0018
• • •	• • • • •					,	
			• • • •		• • • •		
•••						#00FE	#00FF
• • •						*00FF	FFFF

【図14】

	物質ドル	神理が以	FLG		TOP	BTM	VLN			
SYS	h 000000	• —	01	XX · · · XXXX	#000B	#00FF	00F5	XXXX	ジステムトラック言報	XXXX
MF	h 000020	#0000	01	XX XXXX	#0001	#0005	0003	XXXX	斯一分別解	XXXX
R-EF	h 000040	#0001	01	XX XXX	#0002	#0003	0002	XXXX	田 りか 州解報	XXXX
	H 000060	#0002				EF	1			
	H 000080	#0003				EF	1 :			
OF -OF	H 0000A0	#0004	01	XX XX	#0006	#0007	0002	XXXX	日が情報	XXXX
DF1≫	H 000000	#0005	01	XX XXX	#0008	#0008	0001	XXXX	DF 15ック情報	XXXX
	JH 0000E0	#0006	01	#0005		DF10	Dファイ ノ	侶		
	H 000100	#0007	01		-	DF10	ロファイノ	烙		
EF2	H 000120	#0008	01	XX XXXX	#0009	#000A	0002	XXXX	日が州報	XXXX
	H 000140	#0009				EF	2			
	H 000160	#000A				EF	2	5.1		Con
•	H 000180	#000B	FF		FFFF	HH.	FFFF			
	H 0001A0	#000C	F		FFF	FFFF	HHF			
	H 000100	#000D	Æ	is set	##F	FFFF	HHF		45	
	H 0001E0	#000E	FF :	V 2	HH.	FFFF	HTT	A.C.	3374	
	h 000200	#000F	FF	3 T	HH.	FFFF	HHT	0.8	Pala t	
	h' 000220	#0010	F		##F	HH	HH.	2.50	61077	9
:	h 000240	#0011	FF		सस	FFFF	FFFF	10,000	100	
	h 000260	#0012	F		HH.	FFFF	HHF			
	H 000280	#0013	FF		HH	HH	FFFF		X = 15 =	
:	h 0002A0	#0014	FF	# 1 T	HHT.	FFFF	FIFF	10.07		
	H 000200	#0015	Ħ		HH	HHT.	FFFF	1.1	Marketine	
4.	H 0002E0	#0016	Æ		FHF.	FFF	FHF	7.	A7 A34 A	
	H 000300	#0017	FF.		FHF	HHF.	FHF			
		:	HIF							111 1
		• :	FFFF							·FFF
	:	:	HH							HH.

h 050000

H 005010

h 005020

#0000	#0001	#0002	#0003	#0004	#0005	#0006	#0007
HH	#0004	*0003	HTT	+0005	FFFF	+0007	HTF
#0008	#0009	#COOA	#000B	#0000	#0000	#000E	#000F
FFFF	#000A	FFFF	*000C	*000D	*000E	#000F	+0010
#0010	#0011	#0012	#30(3	#0014	#0015	#0016	#0017
*0011	+0012	*0013	+0014	* 0015	*0016	+0017	+0018
				• • • •			• • •
	• • • • •				* * .=	#OOFE	#OOFF
						*00FF	FFFF

【図15】

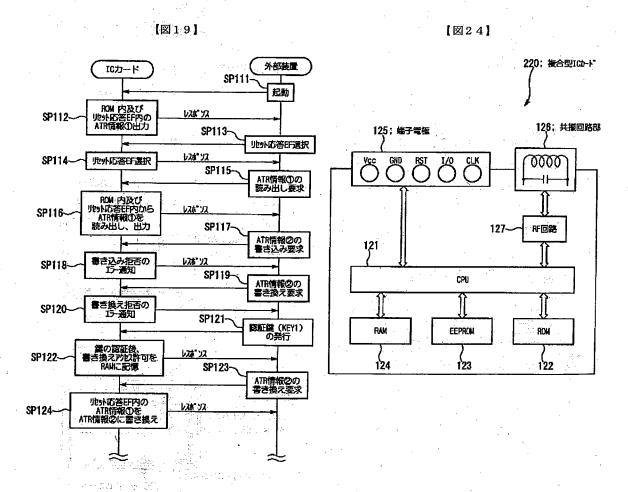
*	物理が以	論理 作以	FLG		TOP	BTM	V.JN	
SYS	H 000000	-	01	xxxxx	#0014	#00FF	QOEC:	XXXX システムトラック情報 XXXX
MF.	H 000020	#0000	01	XX XXXX	#0001	#0005	0003	XXXX MF Iラック情報 XXXX
R-EF	H 000040	#0001	.01	XX XXXX	#0002	#0003	0002	XXXX IF 1ラッケ情報 XXXX
	H 000060	#0002				EF	1	
	H 000080	#0003				ΕF	1	1 NT 1
DF-EF	H 00000AO	#0004	01	XX • • • XXXX	#0006	#000D	0004	XXXX EF 1ラッグ開報 XXXX
DF1	K 000000	#0005	01	XX XXX	#0008	#000B	0002	XXXXX DF 1ラッ分博報 XXXXX
2	H 0000B0	#0006	01	#0005		Ď	FIのファ	rイル名
	K 000100	#0007	01			D	F1のファ	
EF2	H 000120	#0008	01	XXXXX	#0009	#000A	0002	XXXX EF i5:州南和 XXXX
	H 000140	#0009		.,	Ø.	EF	2	et la
	h' 000160	#000A				EF	2	
DF2≫	H 000180	#000B	01	XXXXX	#000E	#0011	0002	XXXX DF Iラッケ作権 XXXX
٠	H-0001AD	#000C	01	#0008		D	F2のファ	Pイル名
1. :	H 000100	#0000	01				F2のファ	
EF3 :	k 0001E0	#000E	01	XX • • • XXXX	#000F	#0010	0002	XXXX DF トラック分割を XXXX
	H 000200	#000F			<u> </u>	EF	3	<u>- 137 - 1450 - 1500 - </u>
	H 000220	#0010		1.0		EF		National Williams
EF4	W 000240	#0011	01	XX XXXX	#0012	#0013	0002	XXXX EF 1ラック情報 XXXX
•	h' 000260	#0012		-		EF		The second second second
	h 000280	#0013		1.5		EF		en vis
	H 0002A0	#0014	FF		FFFF	FFF	FFFF	
	H 000200	#0015	FF	1 1	HHF	IIII	HHF	5 to 16
	H 0002E0	#0016	FF		HHF	THT.	HH	1.00
1	h 000300	#0017	FF	100	HTF	Ш	HH	44
	:	:	FIFF	• • • • • •				••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-	:	:	FIFF	2-1-7-5-				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		: :	FFFF					• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

H 050000 H 005010

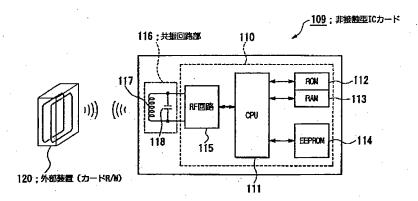
H 005020

#0000	#0001	#0002	#0003	#0004	#0006	#0006	#0007
FFF	#0004	+0003	HHF	*0005	HH	*0007	0000
#0008	#0000	#000A	#XXXB	#CCOC	10000	#000E	#000F
*000B	*000A	FFFF	fHT.	+000D	HTF.	+0011	+0010
#0010	#0011	#0012	#0013	#0014	#0015	#0016	#0017
THE	FFF	+0013	HIF	+0015	+0016	+0017	+0018
					• • • •		• • •
		4, a : 4 · 4 · 4	18 1 W 18 14.	K X F F		#XXFE	#00FF
					• • •	*00FF	FFFF

【図17】 【図18】 ICカード 外部装置 ICカード SP102 RESET 起動 -SP101 リセット応答EFの ID名 (2FO1) を検索 -SP201 ROM内の ATR情報出力 レスポッス SP103 SP104 SP202 リセット応答EF選択 リセット 応答EFのデータ部は 初期状態か? *1/28" '72* リセット応答EF選択 NO SP204 SP106 ATR情報①の 書き込み要求 SP203 -SP105 ROM内及び リセット応答EF内 のATR情報を 読み出し、出力 リセット応答EFに ATR情報のの 書き込み処理実行 ROM内のATR情報 を読み出し、出力 いポソス END



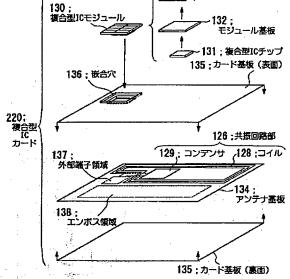
【図23】

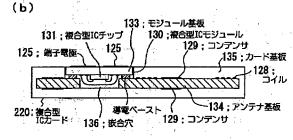


【図25】

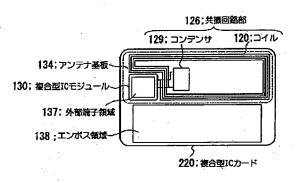
(a)

125 ; 端辺

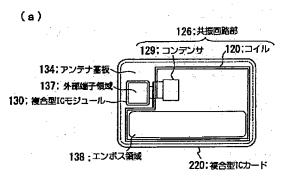


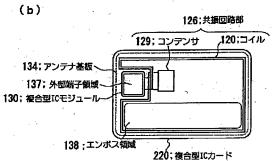


【図26】

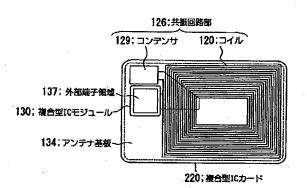


【図27】





【図28】



【図29】

